



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



مقایسه عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی نانو ساختار آلی بر پایه P3HT:PCBM و PCPDTBT:PCBM

سمیه ناظر دپلمی، حمید رضاقلی پوردیزجی

دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده - در این مقاله، با استفاده از مدل اپتیکی، عملکرد اپتیکی سلول خورشیدی آلی ناهمگون حجمی بر پایه $P3HT:PCBM$ و $PCPDTBT:PCBM$ را بررسی کردیم. جذب و آهنگ تولید اکسایتون در لایه فعال محاسبه گردید. چگالی جریان مدار کوتاه بر حسب ضخامت لایه فعال تعیین گردید. نتایج این مدل، پیش بینی می کند که برای لایه فعال با ضخامت های بیشتر از ۱۰۷ نانومتر، سلول خورشیدی آلی بر پایه $PCPDTBT:PCBM$ عملکرد بهتری نسبت به سلول بر پایه $P3HT:PCBM$ دارد.

کلید واژه- سلول خورشیدی آلی، مدل اپتیکی، $P3HT:PCBM$ ، $PCPDTBT:PCBM$

Comparison between Optical Performance of Nanostructured Organic Solar Cell based on P3HT:PCBM & PCPDTBT:PCBM

Somayeh Nazerdeylami, Hamid Rezagholipour Dizaji

Faculty of Physics, Semnan University, Semnan, I. R. of Iran

Abstract- In this paper, we investigated the optical performance of bulk heterojunction organic solar cells (OSCs) based on P3HT:PCBM (poly (3-hexylthiophene): phenyl-C61-butyric acid methyl ester) and PCPDTBT:PCBM (poly[2,6-(4,4-bis-(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b;3,4-b0]dithiophene)-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole)]:phenyl-C61-butyric acid methyl ester). Light absorption and exciton generation rate were calculated in active layer. Short circuit current density was calculated as function of active layer thickness. Results of this model predict that OSCs based on PCPDTBT:PCBM have better performance than P3HT:PCBM based OSCs for active layer thickness more than 107nm.

Keywords: Organic solar cell; Optical modeling; P3HT:PCBM; PCPDTBT:PCBM

۱- مقدمه

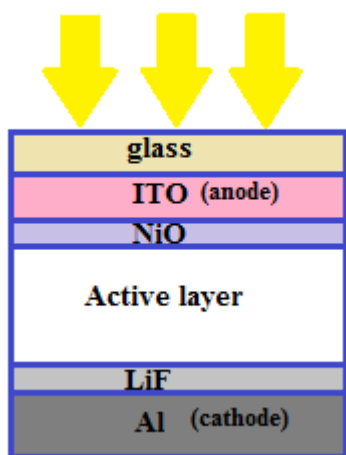
که در آن h ثابت پلانک، c سرعت نور و λ طول موج نور فرودی است. چگالی جریان مدار کوتاه ایجاد شده توسط معادله (۳) بیان می شود [۷]:

$$J_{sc} = e \int G(x) dx \quad (3)$$

که e بار الکترون است.

۳- بررسی نتایج

ساختار سلول در شکل (۱) نشان داده شده است.



شکل ۱: ساختار سلول خورشیدی آلی متشکل از لایه فعال PCPDTBT:PCBM و P3HT:PCBM

ثابت های اپتیکی (n, k) لایه های ITO, NiO, Al, LiF و P3HT:PCBM از مرجع [۷] و PCPDTBT:PCBM از مرجع [۸] بدست آمده است. ابتدا برای یافتن ضخامت بهینه، نمودار چگالی جریان مدار کوتاه بر حسب ضخامت لایه فعال (L) را برای سلول با لایه فعال P3HT:PCBM (ساختار A) و PCPDTBT:PCBM (ساختار B) محاسبه کردیم (شکل ۲). در اینجا، ضخامت لایه از صفر تا سیصد نانومتر تغییر می کند.

در دهه های اخیر سلول های خورشیدی آلی به عنوان منابع جدید تولید جریان الکتریکی از نور، بدلیل انعطاف پذیری، هزینه کم و ساخت آسان مورد توجه قرار گرفته اند [۱، ۲]. فرایند تبدیل نور به جریان الکتریکی شامل جذب فوتون، تولید اکسایتون، جدایش اکسایتون و ترابرد بار به سمت الکترودها در لایه ی فعال سلول رخ می دهد [۳]. بنابراین یکی از عوامل مهم در بازده سلول خورشیدی آلی، ماده، مورفولوژی و ضخامت لایه ی فعال می باشد. لایه فعال با ساختار ناهمگون حجمی دارای بازده بالاتری نسبت به ساختار دولایه ای است [۴]. در سلول خورشیدی آلی، مشتقات فولرین بعنوان پذیرنده الکترون و پلیمرهای مزدوج مانند MEH-PPV، P3HT به عنوان دهنده الکترون استفاده می شود. برای بهبود بازده این نوع از سلول ها و جذب بیشتر نور فرودی، پلیمرهای مزدوج با گاف انرژی کوچکتر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از این مواد PCPDTBT با گاف انرژی ۱/۵ الکترون ولت می باشد [۱].

در این مقاله، با استفاده از مدل اپتیکی، سلول خورشیدی با لایه ی فعال P3HT:PCBM و PCPDTBT:PCBM مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲- مدل اپتیکی

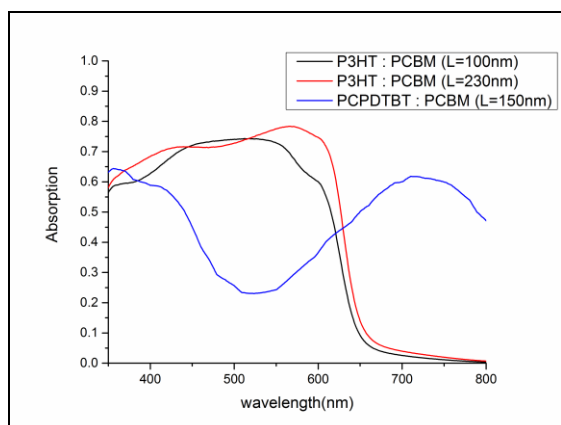
مدل اپتیکی بر اساس روش ماتریس انتقال می باشد که اولین بار توسط پترسون و همکارانش [۵] بر روی سلول خورشیدی آلی مورد استفاده قرار گرفت.

برای نور فرودی عمودی، انرژی جذب شده در لایه ی فعال در مکان x توسط معادله (۱) داده می شود [۵]:

$$Q(x, \lambda) = \frac{1}{2} c \epsilon_0 a n |E(x, \lambda)|^2 \quad (1)$$

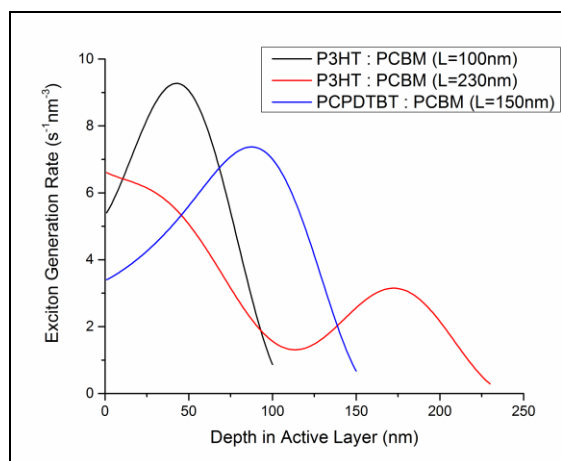
که در آن n و α به ترتیب ضریب شکست و ضریب جذب لایه فعال و $|E(x, \lambda)|^2$ مربع میدان الکتریکی نوری درون لایه فعال است. آهنگ تولید اکسایتون با معادله (۲) داده می شود [۶]:

$$G(x) = \int_{\lambda_1=350}^{\lambda_2=800} \frac{\lambda}{hc} Q(x, \lambda) d\lambda \quad (2)$$



شکل ۳: جذب در لایه فعال ساختار A1، A2 و B1

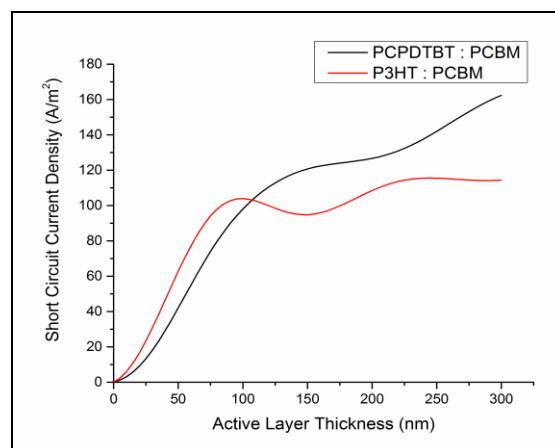
ساختار A1 دارای قله جذب در $\lambda = 540\text{nm}$ به مقدار $73/7\%$ و ساختار A2 دارای قله جذب در $\lambda = 568\text{nm}$ به مقدار $78/4\%$ می باشد. ساختار B1 دارای دو قله جذب در $\lambda = 718\text{nm}$ و $\lambda = 370\text{nm}$ به ترتیب $61/5\%$ و $63/3\%$ می باشد. افزایش جذب در طول موج های بالاتر ناشی از جذب در PCPDTBT است. شکل ۴، نمودار آهنگ تولید اکسایتون بر حسب فاصله از آند در لایه فعال را نشان می دهد. حالت نوسانی نمودار، ناشی از اثرات تداخل اپتیکی است و قله ها نشانگر تداخل سازنده می باشند.



شکل ۴: آهنگ تولید اکسایتون در لایه فعال بر حسب فاصله از آند

۴- نتیجه گیری

عملکرد سلول خورشیدی آلی با استفاده از مدل اپتیکی بر اساس روش ماتریس انتقال بررسی گردید. ساختار B در ضخامت های بیشتر از 107nm نانومتر دارای چگالی جریان مدار کوتاه بزرگتری نسبت به ساختار A است زیرا



شکل ۲: چگالی جریان مدار کوتاه بر حسب ضخامت لایه فعال ساختار A و ساختار B

ساختار A دارای دو قله در ضخامت های 97nm نانومتر و 230nm نانومتر و ساختار B دارای یک قله در 150nm نانومتر و در ضخامت های بیشتر از 207nm نانومتر چگالی جریان افزایشی است. در $L=107\text{nm}$ چگالی جریان هر دو ساختار برابر است. برای ضخامت های کوچکتر از 107nm چگالی جریان ساختار A بزرگتر از چگالی جریان ساختار B است و در ضخامت های بیشتر از $L=107\text{nm}$ کمتر است. در $L=148\text{nm}$ چگالی جریان در ساختار A، 21% درصد کمتر از ساختار B می باشد و این مقدار در $L=272\text{nm}$ به 25% درصد می رسد (جدول ۱).

جدول ۱: مقایسه چگالی جریان در دو ساختار با ضخامت 148nm و 272nm نانومتر

device	L (nm)	J_{sc} (A/m ²)	Improvement (%)
A	148	95.12	
B	148	120.43	21
A	272	114.30	
B	272	152.28	25

بر اساس نتایج شکل ۲، جذب در لایه فعال برای سلول ساختار A با ضخامت $L=100\text{nm}$ و $L=230\text{nm}$ و در ساختار B با ضخامت $L=150\text{nm}$ (ساختارها به ترتیب A1، A2 و B1) را بر حسب طول موج، محاسبه کردیم (شکل ۳).

PCPDTBT گاف انرژی کوچکتری نسبت به P3HT دارد و طول موج های بیشتری را جذب می کند. با افزایش ضخامت در ساختار A، تعداد قله های نمودار آهنگ تولید اکسایتون بدلیل افزایش اثر تداخل اپتیکی، افزایش می یابد. در ادامه کار، از داده های این مقاله برای محاسبه پارامترهای فتوولتائیک (ولتاژ مدار باز، فاکتور پرشوندگی، بازده تبدیل توان) این دو ساختار می توان استفاده نمود.

مراجع

- [1] Boland P., Lee K., Namkoong G., *Device optimization in PCPDTBT:PCBM plastic solar cells*, **Sol. Energy Mater. Sol. Cells**, 94 (2010) 915-920.
- [2] Liang C., Wang Y., Li D., Ji X., Zhang F., He Z., *Modeling and simulation of bulk heterojunction polymer solar cells*, **Sol. Energy Mater. Sol. Cells**, 127 (2014) 67-86.
- [3] Iwan A., Chuchmala A., *Perspectives of applied graphene: polymer solar cells*, **Prog. Polymer Sci.**, 37 (2012)1805-1828.
- [4] Nazerdeylami S., Gholipour Dizaji H., *Effect of active layer thickness on characteristics of P3HT:PCBM based organic solar cells*, **5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology**, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 22-24 October 2014.
- [5] A. A. Pettersson L., S. Roman L., Inganas O., *Modeling photocurrent action spectra of photovoltaic devices based on organic thin films*, **J. Appl. Phys.** 86 (1999) 487.
- [6] Albrecht S., Schafer S., Lange I., Yilmaz S., Dumsch I., Allard S., Scherf U., Hertwig A., Neher D., *Light management in PCPDTBT :PC70BM solar cells: A comparison of standard and inverted device structures*, **Org. Electron.** 13 (2012) 615-622.
- [7] E. Petoukhoff C., K. Vijapurapu D., M. Ocarroll D., *Computational comparison of conventional and inverted organic photovoltaic performance parameters with varying metal electrode surface workfunction*, **Sol. Energy Mater. Sol. Cells**, 120 (2014) 572-583.
- [8] G. Dennler, K. Forberich, T. Ameri, C. Waldauf, P. Denk, C. J. Brabec, *Design of efficient organic tandem cells: On the interplay between molecular absorption and layer sequence*, **J. Appl. Phys.** 102 (2007) 123109-6.